

SOD-123 Schottky Barrier Rectifier Diode 肖特基势垒整流二极管

■Features 特点

Low forward voltage drop 低正向压降

High current capability 高电流能力

Surface mount device 表面贴装器件

Case 封装:SOD-123

Marking 印字: 76



■Maximum Rating 最大额定值

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

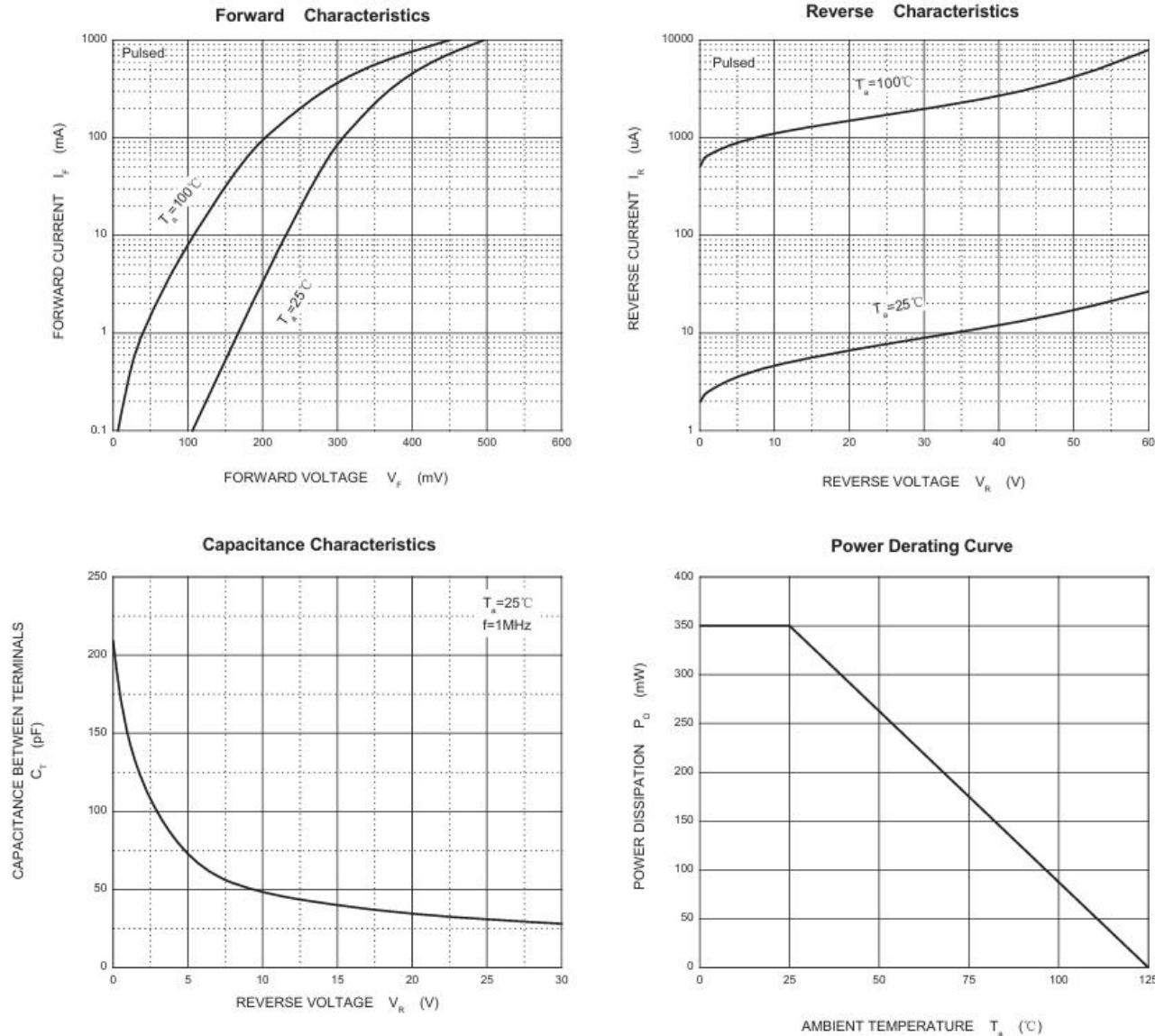
Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
DC Reverse Voltage 直流反向电压	V_R	60	V
RMS Reverse Voltage 反向电压均方根值	$V_{R(\text{RMS})}$	42	V
Forward Rectified Current 正向整流电流	I_F	1	A
Peak Surge Current 峰值浪涌电流	I_{FSM}	15	A
Power Dissipation 耗散功率	P_D	350	mW
Thermal Resistance J-A 结到环境热阻	$R_{\theta JA}$	286	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction Temperature 结温/储藏温度	T_J	-40to+125	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature 结温/储藏温度	T_{stg}	-50to+150	$^\circ\text{C}$

■Electrical Characteristics 电特性

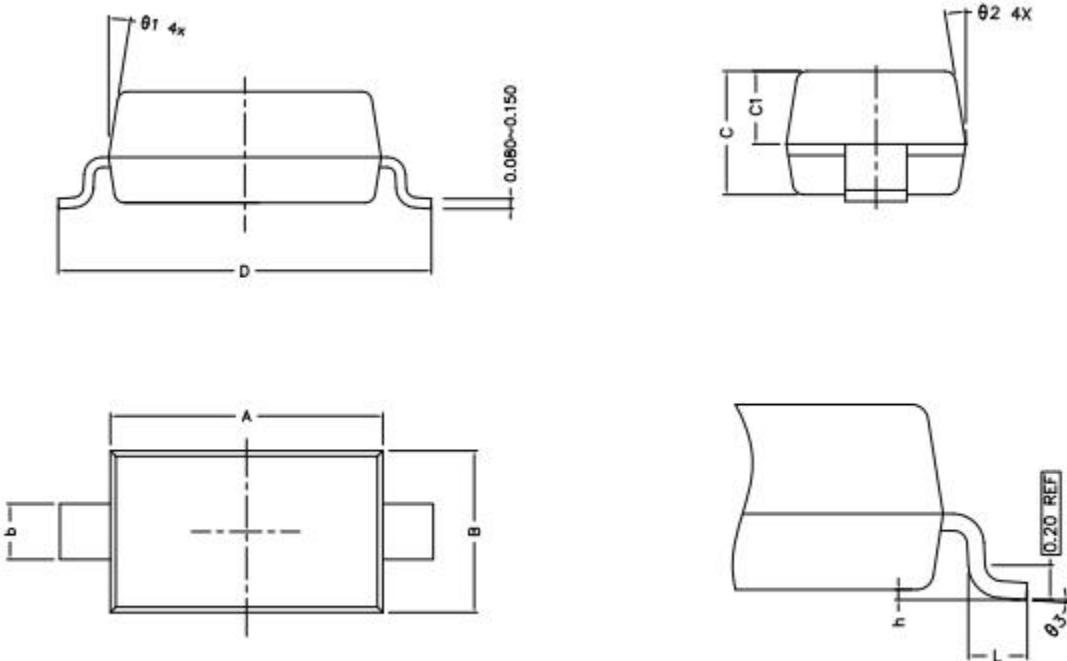
($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位	Condition 条件
Reverse Voltage 反向电压	V_R	60			V	$I_R=1\text{mA}$
Forward Voltage 正向电压	V_F			0.58	V	$I_F=0.2\text{A}$
Reverse Current 反向电流	I_R			30	μA	$V_R=60\text{V}$
Diode Capacitance 二极管电容	C_T		80		pF	$V_R=4\text{V}, f=1\text{MHz}$

■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线



■ Dimension 外形封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	2.600	2.800	0.102	0.110
B	1.500	1.700	0.059	0.067
C	1.050	1.150	0.041	0.045
C1	0.600	0.700	0.024	0.028
D	3.550	3.850	0.140	0.152
L	0.250	0.450	0.010	0.018
b	0.450	0.650	0.018	0.026
h	0.020	0.120	0.001	0.005
Θ 3	0°	7°	0°	7°